



2SC2412K (3DG2412K)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于普通放大。

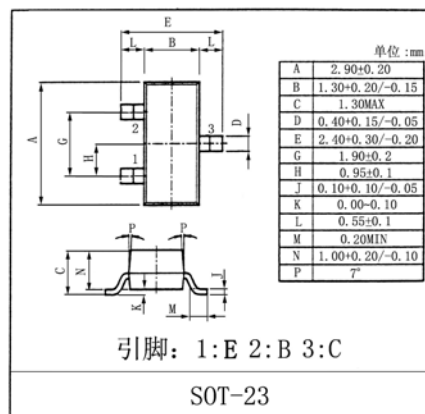
Purpose: General amplifier.

特点:共基极输出电容小。

Features: Low C_{ob} .

极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	60	V
V_{CE0}	50	V
V_{EB0}	7.0	V
I_C	150	mA
P_C	200	mW
T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}	$-55\sim 150$	$^{\circ}\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=50\mu\text{A}$	60			V
V_{CE0}	$I_C=1.0\text{mA}$	50			V
V_{EB0}	$I_E=50\mu\text{A}$	7.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=60\text{V}$			0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=7.0\text{V}$			0.1	μA
h_{FE}	$V_{CE}=6.0\text{V}$ $I_C=1.0\text{mA}$	120		560	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=50\text{mA}$ $I_B=5.0\text{mA}$			0.4	V
f_T	$V_{CE}=12\text{V}$ $I_E=-2.0\text{mA}$ $f=100\text{MHz}$		180		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=12\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		2.0	3.5	pF

h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	Q	R	S
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	120~270	180~390	270~560
印章 Marking	HBQ	HBR	HBS

